TM1637

特性描述

TM1637 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字 接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉、微波 炉及小家电产品的显示屏驱动。采用DIP/SOP20的封装形式。

功能特点

- ➤ 采用功率CMOS 工艺
- ▶ 显示模式(8 段×6 位),支持共阳数码管输出
- ▶ 键扫描(8×2bit),增强型抗干扰按键识别电路
- ▶ 辉度调节电路(占空比 8 级可调)
- 两线串行接口(CLK, DIO)
- ▶ 振荡方式: 内置RC 振荡
- ▶ 内置上电复位电路
- ▶ 内置自动消隐电路
- ▶ 封装形式: DIP20/SOP20

管脚信息

GND	1 🔾	20	K2
SEG1/KS1	2	19	K1
SEG2/KS2	3	18	CLK
SEG3/KS3	4	17	DIO
SEG4/KS4	5	16	VDD
SEG5/KS5	6	15	GRID1
SEG6/KS6	7	14	GRID2
SEG7/KS7	8	13	GRID3
SEG8/KS8	9	12	GRID4
GRID6	10	11	GRID5
			J

2



管脚功能

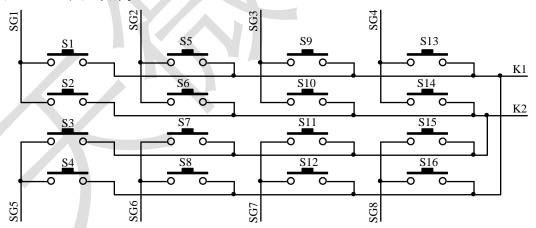
符号	管脚名称	管脚号	说明
DIO	数据输入/输出	17	串行数据输入/输出,输入数据在 SLCK 的低电平变化,在 SCLK 的高电平被传输,每传输一个字节芯片内部都将在第 八个时钟下降沿产生一个 ACK
CLK	时钟输入	18	在上升沿输入/输出数据
K1~K2	键扫数据输入	19-20	输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存
SG1~SG8	输出(段)	2-9	段输出(也用作键扫描),N 管开漏输出
GRID6~GRID1	输出(位)	10-15	位输出,P管开漏输出
VDD	逻辑电源	16	接电源正
GND	逻辑地	1	接系统地



在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,天微电子建议采取一切适当的 集成电路预防处理措施,如果不正当的操作和焊接,可能会造成ESD损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。

读键扫数据

键扫矩阵为8×2bit,如下所示:



在有按键按下时,读键数据如下:

	SG1	SG2	SG3	SG4	SG5	SG6	SG7	SG8
K1	1110_11	0110_11	1010_11	0010_11	1100_11	0100_11	1000_11	0000_11
	11	11	11	11	11	11	11	11
K2	1111 <u>_</u> 01	0111_01	1011_01	0011_01	1101_01	0101_01	1001_01	0001_01
	11	11	11	11	11	11	11	11

注意: 在无按键按下时,读键数据为: 1111_1111,低位在前,高位在后。由于在电磁炉等厨房电器应用中,由于干扰较强,为 改善这个问题, TM1637 采用负沿触发方式解决误触发现象, 即所谓"跳键"现象, TM1637 不支持组合按键。

LED 驱动控制专用电路

TM1637

显示寄存器地址和显示模式

该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1637的数据,地址00H-05H共6个字节单元,分别与芯片SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图:

写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。

SEG5	SEG4	SEG5 SEG4	SEG7	SEG8	
X		XX	HU(高四位		
B4	ВЗ	B3 B4	B5 B6	В7	
			00HU		GRID1
			01HU		GRID2
			02HU		GRID3
			GRID4		
04HU			04HU	GRID5	
			05HU		GRID6

接口说明

微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1637 通信,在输入数据时当 CLK 是高电平时,DIO 上的信号必须保持不变;只有 CLK 上的时钟信号为低电平时,DIO 上的信号才能改变。数据输入的开始条件是 CLK 为高电平时,DIO 由高变低;结束条件是 CLK 为高时,DIO 由低电平变为高电平。

TM1637 的数据传输带有应答信号 ACK, 当传输数据正确时, 会在第八个时钟的下降沿, 芯片内部会产生一个应答信号 ACK 将 DIO 管脚拉低, 在第九个时钟结束之后释放 DIO 口线。

1、指令数据传输过程如下图(读按键数据时序)



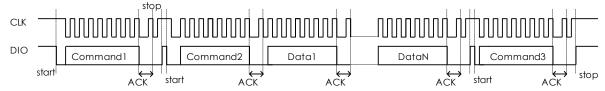
Command: 读按键指令; S0、S1、S2、K1、K2 组成按键信息编码, S0、S1、S2 为 SGn 的编码, K1、K2 为 K1 和 K2 键的编码, 读按键时, 时钟频率应小于 250K, 先读低位, 后读高位。

3

LED 驱动控制专用电路

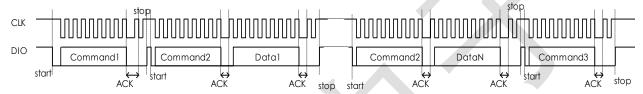
TM1637

2、写 SRAM 数据地址自动加 1 模式



Command1: 设置数据 Command2: 设置地址 Data1~N: 传输显示数据 Command3: 控制显示

3、写 SRAM 数据固定地址模式



Command1:设置数据 Command2:设置地址 Data1~N:传输显示数据 Command3:控制显示

数据指令

指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。

在CLK下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。

	В7	В6	指令					
1	0	1	数据命令设置					
	1	0	显示控制命令设置					
	1	1	地址命令设置					

如果在指令或数据传输时发送STOP命令,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)

TM1637

1、数据命令设置

该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。

MSB LSB

В7	В6	В5	B4	В3	B2	В1	во	功能	说明	
0	1					0	0	数据读写模式设置	写数据到显示寄存器	
0	1					1	0	奴	读键扫数据	
0	1	无关项	页,填		0			地址增加模式设置	自动地址增加	
0	1	()		1			地址培加侯入反直	固定地址	
0	1			0				测试模式设置(内	普通模式	
0	1			1				部使用)	测试模式	

2、地址命令设设置

MSE	}			LSB				
В7	В6	B5	В4	В3	B2	B1	во	显示地址
1	1			0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1	无关项	页,填	0	0	1	0	02H
1	1	()	0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H

该指令用来设置显示寄存器的地址;如果地址设为0C6H 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定;上 电时,地址默认设为00H。

3、显示控制

LSB **MSB**

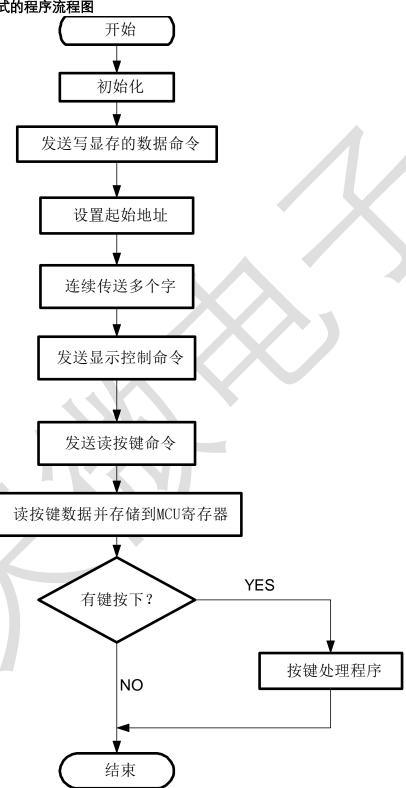
В7	B6	B5	B4	В3	B2	В1	во	功能	说明
1	0				0	0	0		设置脉冲宽度为 1/16
-1	0				0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16
1	0				0	1	0		设置脉冲宽度为 4/16
1	0				0	1	1	冰小粉皂 沉黑	设置脉冲宽度为 10/16
1	0	无关项	页,填		1	0	0	消光数量设置	设置脉冲宽度为 11/16
1	0	C)		1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0				1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0				1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0				显示开关设置	显示关
1	0			1				业小开大权直	显示开

5



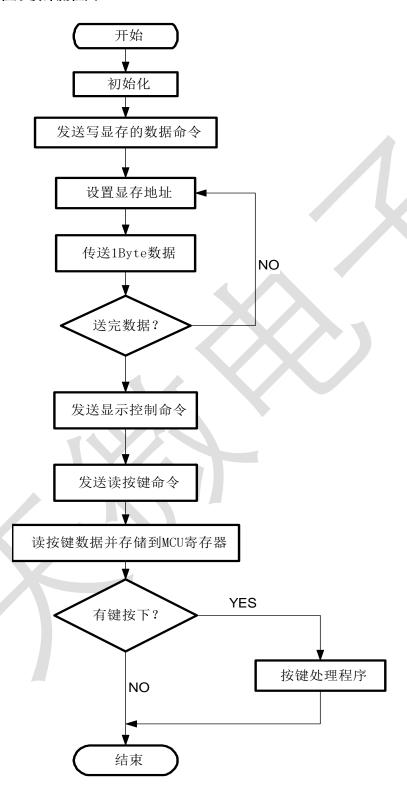
程序流程图

1、采用地址自动加一模式的程序流程图





2、采用固定地址的程序设计流程图

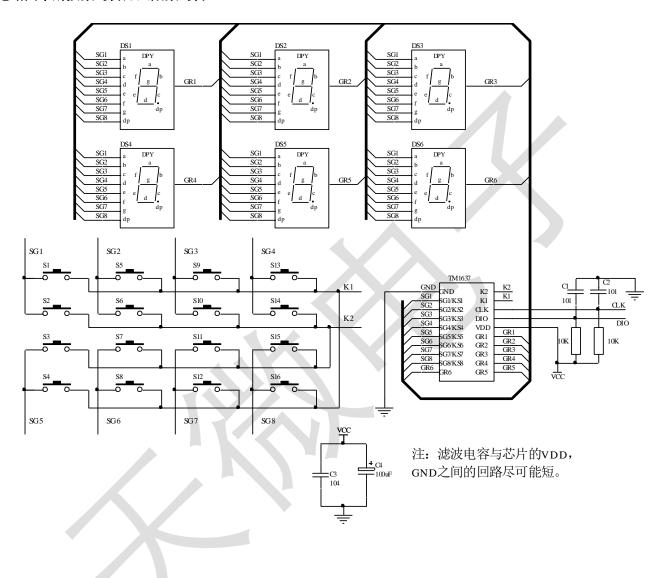


8



硬件连接图

电路图中所接数码管为共阳数码管



9



电气参数:

1、极限参数 (Ta = 25℃, Vss = 0 V)

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 ~+ 7.0	>
逻辑输入电压	VII	-0.5 ~ VDD + 0.5	V
LED SEG 驱动灌电流	IO1	50	mA
LED GRID 驱动拉电流	IO2	200	mA
功率损耗	PD	400	mW
工作温度	Topt	-40 ~ +85	°C
储存温度	Tstg	-65 ~+150	°C

2、正常工作范围 (Ta = -40~+85℃, Vss = 0 V)

参数	符号最小		典型	最大	单位	测试条件
逻辑电源电压	VDD		5		V	-
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-	VDD	>	-
低电平输入电压	VIL	0	-	0.3 VDD	٧	-

3、电气特性 (Ta = -40~+85℃, VDD = 4.5 ~ 5.5 V, Vss = 0 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
GRID驱动拉电流	loh1	80	120	180	mA	GRID1~GRID6, Vo=vdd-2V
	loh2	80	140	200	mA	GRID1~GRID6, Vo=vdd-3V
SEG驱动灌电流	IOL1	20	30	50	mA	SEG1~SEG8 Vo=0.3V
DOUT脚输出低电平电流	Idout	4	-	-	mA	VO = 0.4V, dout
高电平输出电流容许量	Itolsg	-	-	5	%	VO = VDD - 3V, GRID1∼GRID6

输入上拉电阻	RL		10		ΚΩ	K1~K2
输入电流	II	-	-	±1	μΑ	VI = VDD / VSS
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-		٧	CLK, DIN
低电平输入电压	VIL	-	-	0.3 VDD	V	CLK, DIN
滞后电压	VH	-	0.35	-	>	CLK, DIN
动态电流损耗	IDDdyn	-	-	5	mA	无负载,显示关

4、开关特性 (Ta = -40~+85℃, VDD = 4.5 ~ 5.5 V)

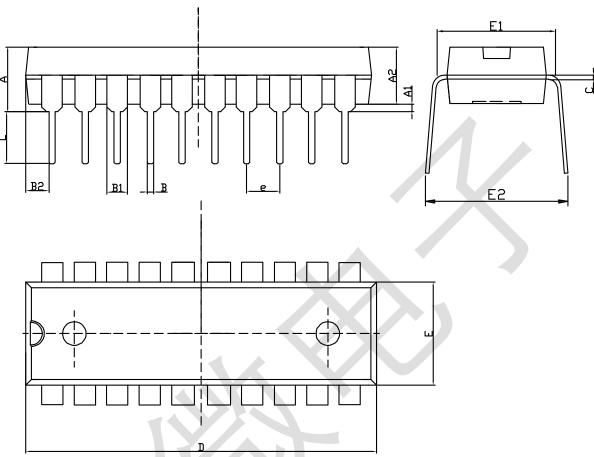
	2 (
参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件		
振荡频率	fosc	-	450	-	KHz			
	†PLZ	-	-	300	ns	CLK	CLK → DIO	
传输延迟时间	†PZL	-	-	100	ns	CL = 15pF, RL = 10K Ω		
	TTZH 1	-		2	μs	CL = 300p F	GRID1∼ GRID6	
上升时间	TTZH 2	-	7	0.5	μs		SEG1~ SEG8	
下降时间	TTHZ		-	120	μs	CL = 300pF, Segn, Gridn		
最大时钟频率	Fmax	-	-	500	KHz	占空比50%		
输入电容	CI	-	-	15	рF	-		

5、时序特性 (Ta = -40 ~+85℃, VDD = 4.5 ~ 5.5 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
时钟脉冲宽度	PWCLK	400	-	-	ns	-
数据建立时间	tSETUP	100	-	-	ns	-
数据保持时间	†HOLD	100	-	-	ns	-
等待时间	tWAIT	1	-	-	μs	CLK ↑ →CLK ↓

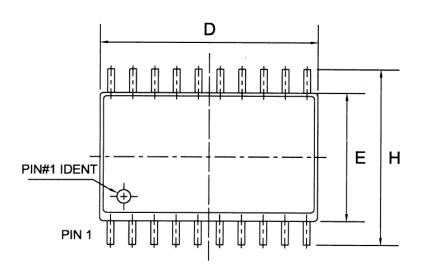


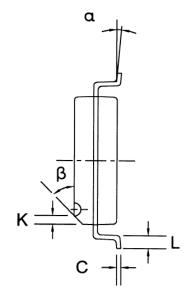
IC封装示意图 DIP20

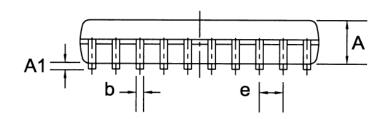


<i>h</i> h 口	单位: 毫米				
符号	最小值	典型值	最大值		
A	3.71	4.00	4.31		
A1	0.50	0.60	0.80		
A2	3.20	3.40	3.60		
В	0.33	0.45	0.53		
B1	1.525(TYP)				
C 0.20		0.28	0.36		
D	25.70	26.00	26.54		
E	6.20	6.40	6.75		
E1	7.32	7.78	8.25		
e					
L 3.00		3.30	3.60		
E2	8.20	8.70	9.10		
B2	0.87	1.02	1.17		

SOP20







Symbol	Dimensions In Millmeters			Dimensions In Inches			
Symbol	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	
Α	2.15	2.35	2.55	0.085	0.093	0.100	
A1	0.05	0.15	0.25	0.002	0.006	0.010	
b		0.40			0.016		
С		0.25			0.010		
D	12.40	12.70	13.00	0.488	0.500	0.512	
E	7.40	7.65	7.90	0.291	0.301	0.311	
е		1.27			0.050		
Н	10.15	10.45	10.75	0.400	0.411	0.423	
K		0.50			0.020		
L	0.60	0.80	1.00	0.024	0.031	0.039	
α	o°		8 *	0 0		8 °	
β		45°			45°		